

追加2pF檔位以提升微小電容測定時精確度、穩定度
藉由定電壓測定方式適用於高電容值的多層陶瓷電容之測包機檢查製程



- 可切換串聯等價回路、並聯等價回路
- 可定電壓信號測定(一部份檔位不對應)
- 可測定 $\tan \delta$ (不對應2pF RANGE)
- 施加間歇狀測定電流[120 μ F/1.2mF RANGE],以減少接觸探針的磨損
- 各檔位可選擇三端點/五端點接觸檢知(CONTACT CHECK)
- 從微小容量到大容量廣泛範圍測定檔位[2pF~1.2mF RANGE]
- 具3位半顯示(1999)及LO/GO/HI, 接觸錯物(CONTACT ERROR)信號輸出
- 超高速測定:測定時間 代表值 [1.2msec.:FAST MODE]
- 搭載RS-232C

Specifications

測定範圍及準確度(周圍溫度23°C \pm 5°C)※D \leq 0.1 並聯等價回路

測定檔位	測定範圍	最小解析度	測定準確度	測定電壓	
2pF	0.000pF~ 1.999pF	0.001pF	$\pm 1.0\%$ of rdg $\pm 5\text{digit} \times \alpha$ 以內	1kHz, 5V $\pm 5\%$ [rms]	
20pF	0.00pF~ 19.99pF	0.01pF	$\pm 0.25\%$ of rdg $\pm 3\text{digit} \times \alpha$ 以內		
200pF	0.0pF~ 199.9pF	0.1pF	$\pm 0.2\%$ of rdg $\pm 2\text{digit} \times \alpha$ 以內	1kHz, 1V $\pm 5\%$ [rms]	
2nF	0.000nF~ 1.999nF	0.001nF	$\pm 0.2\%$ of rdg $\pm 2\text{digit}$ 以內		
20nF	0.00nF~ 19.99nF	0.01nF			
200nF	0.0nF~ 199.9nF	0.1nF			
2 μ F	0.000 μ F~1.999 μ F	0.001 μ F	$\pm 0.3\%$ of rdg $\pm 3\text{digit} \times \alpha$ 以內	120Hz, 0.5V $\pm 5\%$ [rms]	
20 μ F	0.00 μ F~19.99 μ F	0.01 μ F	$\pm 1.0\%$ of rdg $\pm 5\text{digit} \times \alpha$ 以內	1kHz, 1V $\pm 5\%$ ~ -40% [rms]	
120 μ F	0.0 μ F~120.0 μ F	0.1 μ F	$\pm 0.5\%$ of rdg $\pm 3\text{digit} \times \alpha$ 以內		
200 μ F	0.0 μ F~199.9 μ F	0.1 μ F	$\pm 1.5\%$ of rdg $\pm 5\text{digit} \times \alpha$ 以內		120Hz, 0.5V $\pm 5\%$ [rms]
1.2mF	0.000mF~ 1.200mF	0.001mF			120Hz, 0.5V $\pm 5\%$ ~ -50% [rms]

※0.1<D<1時, 上述準確度加算25D/100(%)

※ α :FAST時為 2(2.00pF 1.0V 時 $\alpha=10$), SLOW時為1(2.00pF 1.0V時 $\alpha=5$)

測定方式	五端點測定方式[各檔位可選擇]、並聯等價回路及串聯回路換算顯示
測定頻率	120Hz/1kHz $\pm 0.1\%$ 、正弦波
信號源輸出阻抗	約1.5 Ω
寄生電容補償範圍	約30pF
全核度及零點溫度係數	$\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 以內
測定時間	Free Running周期:FAST:約1~5次/秒 SLOW:FAST \times N(N:平均值設定次數) 自外部啟動到INDEX信號的時間:FAST:1.2 sec(代表值)
比較器設定範圍	Capacitance: HI/LO皆為1999 [120 μ F, 1.2mF檔位HI/LO皆為1199] $\tan \delta$: 99.9%
使用周圍環境	溫度: 5°C~+40°C、濕度: 85%以下
電源需求	AC85V~265V切換、50/60Hz、約50VA
外觀尺寸	約333(W) \times 99(H) \times 300(D)mm (不包含橡膠墊等凸出物。)
重量	約4.0Kg